



半导体分立器件
LYCS30N60 型大功率 N 沟道场效应
晶体管产品手册

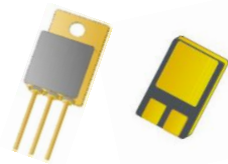
济南晶恒电子有限责任公司

V1.1

LYCS30N60 型大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1 产品概述

LYCS30N60 是大功率 N 沟道场效应晶体管之一，采用 VDMOSFET 工艺制造。在整机电子线路中具有放大、开关作用，也可用作动态阻抗和恒流源等。



TO-257 型 SMD-0.5 型

2 ZZKK 情况

LYCS30N60 型大功率 N 沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

可提供 SMD-0.5 金属陶瓷封装和 TO-257 型通孔插装。

具有开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小安全工作区宽，温度稳定性好的特点。

器件的静电放电敏感度为人体模式 1C 级，1000V。SMD-0.5 型封装的典型重量为 1.0g；TO-257 型封装典型重量 4.3g。

4 可提供质量等级

J 级；

G、G+级：Q/RBJ1005QZ，QZJ840611。

5 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	P_D^a ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) W	V_{GS} V	I_{DM1} ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) A	I_{DM2} ($T_c=100^{\circ}\text{C}$) A	$R_{th(j-c)}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$	封装形式
LYCS30N60 (R) T	63	± 20	30	20	2	$-55\sim 150$	$-55\sim 150$	TO-257
LYCS30N60 (R) U								SMD-0.5

^a 当 T_c 超过 25°C 时，按 $0.5\text{W}/^{\circ}\text{C}$ 线性降额。

6 主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	60	—	—	V
2	阈值电压 ^a	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	1.0	—	3.0	V
3	导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=20A$	—	—	10	mΩ
4	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$	—	—	1	μA
5	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$	—	—	100	nA
6	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20V, V_{DS}=0V$	—	—	100	nA
7	开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=30V, V_{GS}=10V, I_D=20A, R_G=4.7\Omega$	—	18	—	ns
	上升时间	t_r		—	69	—	ns
	关断延迟时间	$t_{d(off)}$		—	62	—	ns
	下降时间	t_f		—	104	—	ns
8	栅电荷	Q_g	$V_{DD}=30V, I_D=20A, V_{GS}=10V$	—	70	—	nC
		Q_{gs}		—	12.87	—	nC
		Q_{gd}		—	13.40	—	nC
9	电容	C_{iss}	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	4128	—	pF
		C_{oss}		—	1957	—	pF
		C_{rss}		—	418	—	pF

^a 为保证器件完全开启，使用时建议 V_{GS} 在 6V 以上，导通电阻随 V_{GS} 的升高逐渐减小。

7 特性曲线

由于国产芯片的离散性，以下曲线仅供参考，具体使用以实际情况为准。

7.1 $T_J=25^{\circ}C$ 时， I_D 随 V_{GS} 的变化曲线

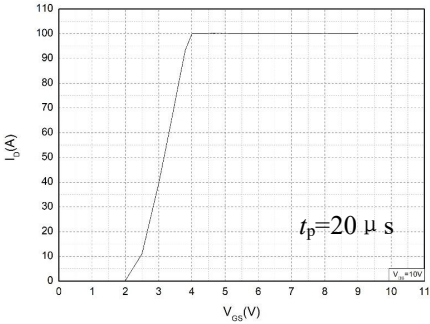


图 1 转移特性曲线

7.2 $V_{GS}=0V, T_J=25^{\circ}C$ 时，体二极管正向电流 I_{SD} 与正向压降 V_{SD} 的关系

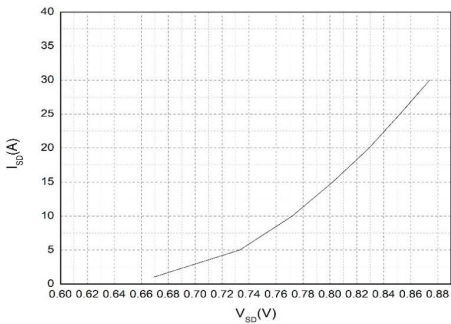


图 2 体二极管特性曲线

7.3 $V_{GS}=10V$, $I_D=20A$ 时, $R_{DS(on)}$ 随温度 T_J 的变化曲线 7.4 $V_{GS}=0V$, $f=1MHz$ 时, 电容 C 随 V_{DS} 的变化曲线

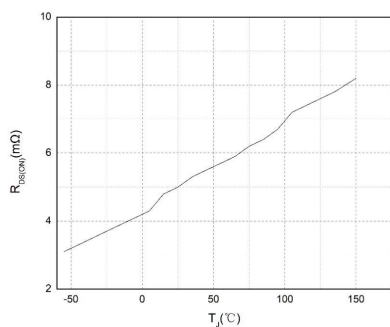


图 3 $R_{DS(on)}-T_J$ 特性曲线

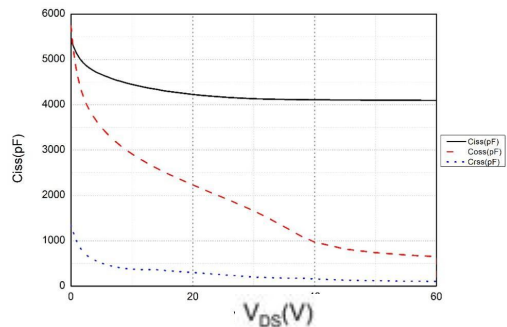


图 4 电容曲线

7.5 $I_D=30A$ 时, 不同 V_{DS} 下, Q_g 随 V_{GS} 的变化曲线 7.6 安全工作区曲线

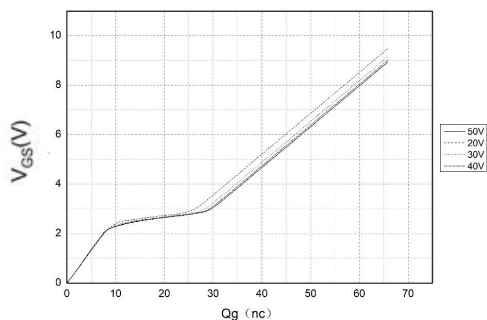
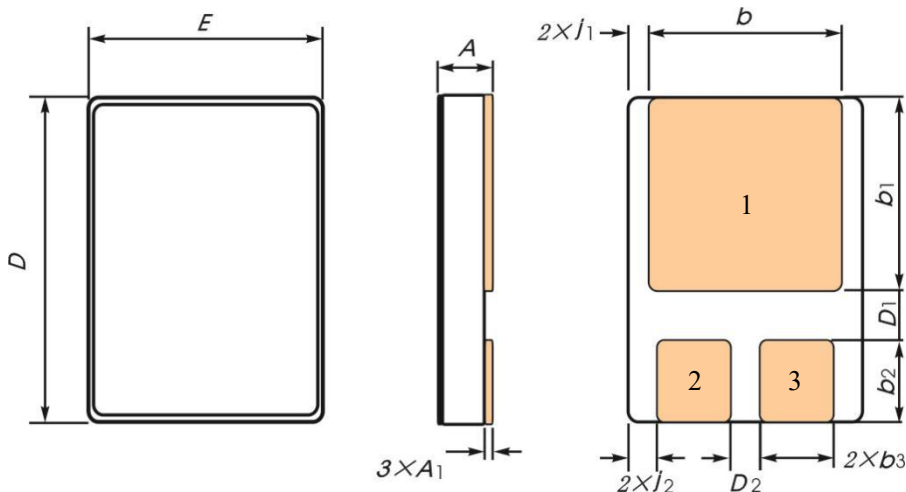


图 5 特性曲线



图 6 安全工作区曲线

8 外形尺寸



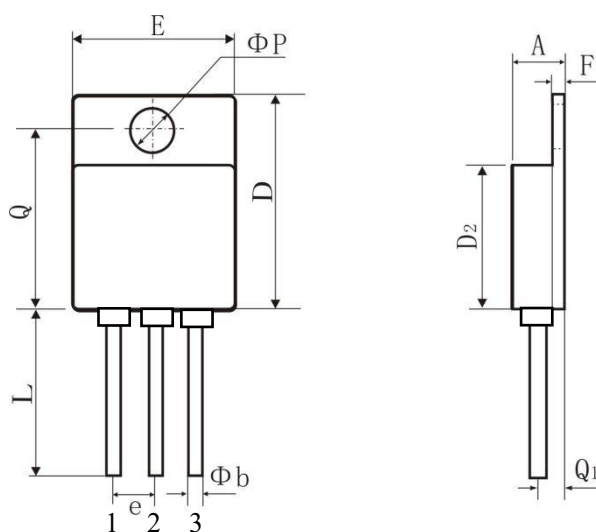
注: LYCS30N60U 引出端极性 (底视图): 1-D, 2-S, 3-G;

LYCS30N60RU 引出端极性 (底视图): 1-D, 2-G, 3-S;

单位为毫米

封装 外形		符 号		A	A_1	b	b_1	b_2	b_3	D	D_1	D_2	E	j_1	j_2
		尺 寸													
SMD-0.5	最小值	—	0.15	6.92	5.49	2.83	2.19	9.94	0.60	0.70	7.30	—	0.15		
	最大值	3.29	0.61	7.57	6.30	3.27	2.64	10.45	—	—	7.81	0.35	0.87		

图 7 SMD-0.5 型封装外形尺寸



注: LYCS30N60T 引出端极性: 1-G, 2-D, 3-S;

LYCS30N60RT 引出端极性: 1-D, 2-S, 3-G。

单位为毫米

封 装 形 式 尺 寸 符 号		A	Φb	D	D_2	E	e	F	L	Q	Q_1	Q_2	ΦP
		A	Φb	D	D_2	E	e	F	L	Q	Q_1	Q_2	ΦP
T0-257	最小值	4.83	0.64	16.39	10.42	10.42	2.24	0.89	10.70	12.80	2.75	—	3.50
	最大值	5.08	0.88	16.89	10.92	10.75	2.84	1.14	15.88	14.19	3.35	14.90	3.78

图 8 T0-257 外形尺寸

9 典型应用

该产品为单极型的电压控制器件，在电子线路中主要起开关或放大作用，典型的开关电路如图 9，共漏极放大电路如图 10。

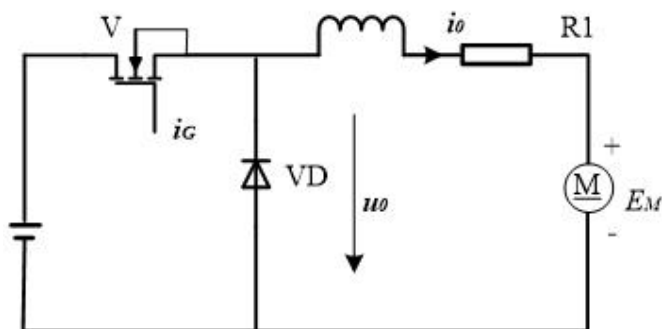


图 9 典型开关电路

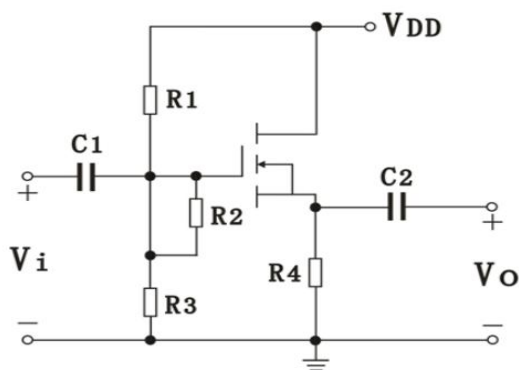


图 10 共漏极放大电路

10 注意事项

产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

10.1 降额设计

- 线路设计应保证与额定值比有足够的余量；
- 器件使用时最大结温不超过 150°C ，环境温度不超过 $-55^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$ 。

10.2 产品使用和防护

- 器件应在防静电的工作台上操作；
- 试验设备和器具应接地；
- 不能直接用手触摸器件引线，应佩戴防静电指套和腕带；
- 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

10.3 产品焊接

镀金引线或焊端均应进行除金处理，不允许在镀金引线或者焊端上直接焊接。可以使用手工焊接、回流焊接两种焊接方式，手工焊接温度不超过 260°C ，焊接时间不超过 10s。使用回流焊炉推荐使用约 183°C 的低熔点焊料焊接，在保证焊接质量的情况下，峰值温度可以适当降低，典型的回流焊接温度工艺曲线如图所示。



12 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路 13856 号晶恒工业园

技术咨询

电话：0531-87225289 传真：0531-86593255

电话：0531-86593255 传真：0531-86593255

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345